This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

40 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭60-195957

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

の代 理 人

リードフレーム

弁理士 高橋

展 昭59-50939 创特

の出 頤 昭59(1984)3月19日

砂発 明 者 谷川 番 太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 者

明夫

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

株式会社日立製作所 砂出 殿 人

外1名

特許請求の範囲

1. 偏面に突出部を設けて成ることを特徴とする

2. 前記リードフレームがプラステックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技智分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの密着性を良くし、對止性のよい樹脂 對止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に 示すごときものが異知である。(工業調査会刊「I C 化奥装技術」P137~P150など)。第1図K て、1は半導体チップをマウントするメブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導 という田で問題があることがわかった。

体チップの内部配銀をコネクタワイヤにより外部 **に引出するリードである。このリード何の電板及** び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングレて電気的接続を行った後に、樹脂(レ **ジン)を周知のトランスファーモールト法などに** より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止母半導体装置にあっ 'ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 化し、対止性(耐圧性)を向上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その何面が フラットに構成されており、リードフレームとレ グンとの密着性が不足し、対止性、信頼度の向上

TECHNOLOGY CO. TO THE PROPERTY OF THE STREET OF THE STREET

〔発明の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの密定(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密定性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂対止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前配ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および抵付図面からあきらかになるであろう。

[発明の概要]

本裏において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面環増大によるリータバスの伸長 をはかって外部からの復気等の浸透性異物の侵入 の半導体チェブへの到達時間を長くして、封止性 を再上させ、製品寿命を延命し、信頼性を再上させることに成功した。

〔疾始仍〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの、要部針視回、 第3回は第2回I-I線斯面回を示す。

これら図において、4は半導体チャブを搭載するためのタが、5はタブ吊りリード、6はリード、7は樹脂でである。本発明リード、6はリード、7は樹脂でである。本発明リードであっては、これら図に例示するように、タブ4をタットであっては、これら図がファントを関するように、タブ4をタットである。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により標面がファットを形成されたアンスを様により押圧してもよいののでは、フェッチングにより周端最から通宜機を上下から返すったより周端最から通宜機を上下から返すった。ファチングにより周端最から通宜機を上下から返すった。その他通宜の方法が採用できる。

鉱4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂對止型半導体接電の断面図を示し、第4 個に て、9 は半導体チェブ、10 はコネクタワイヤ。 11 は樹脂對止体、12 はリードフレームで半導 体チェブ9を搭載しているタブ13、及び半導体 チェブ9の内部配数をコネクタワイヤ10を用い て外部に引出するリード14 にはそれぞれ突出部 15 が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単縮晶蓋板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の個路集子が形成され、1つの回路機能を与えている。 四路素子は例えば、絶機ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキン樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、連宜の関係で横方向に複数の線系の溝部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂對止型半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14の樹脂對止体11に組込まれる長さが次額に短くなってきている。そうすると、リード14を折曲げて第4図に示すような折曲げリードを折曲けリードがゆるみ、リードとする場合、折曲げ時にリードが増脂対止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔劝 录〕

- (1) リードフレームの切断面に良付けを行ない、 何面に奥出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られる。
- (2) 密想節役の増大により、レジン量が増大し、

特爾昭60-195957(3)

かつ、毎回がフラットである場合に比較して、夏 が形成されているのでリークパスが長くなり、そ の結果外部からの半導体製量内部への侵渡性異物 の侵入が選くなり剣止性(耐磁性)が向上する。

- (3) リードフレームとレジンとの密着性。對止性 の向上により製品寿命を延命し、樹脂剣止穏半導 体製量の信頼性を着しく自上することができる。
- (4) 半導体チップが大型化し、リードのモールド レジン中へ組め込まれている部分が増々低くなっ ている今日、リードフレームに及付けを行い、リ ードフレームとレジンとの密着性の向上の図り、 対止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得 ることは工業上額めて存意義である。
- (5) リードフレームの何節に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの告着性が貴上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるん だり、樹脂對止体の外部に突出したりすることを 防止できる。

以上本苑明者によってなされた苑明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上配実施 例に限定されるものではなく、その長旨は途脱し ない範囲で建々変更可能であることはいうまでも

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 金体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前配実施例では講部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに飲けてもよい。 〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)ダイブのパ ッケージの他、フラットパックタイプのパッケージ など他の機能対止電半導体装置にも運用すること ができ、樹脂對止歴半導体製産金数に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3回は第2回I-I蘇斯面図、

- 第4 図は本発明-11 ードフレニュを使用して成る 樹龍對止挺半導体養量の新面配、

第 5 図は本発明の他の実施例を示すりードフレ

ームの平面図である。

1 …タブ、2 …タブ吊り リード、3 …リード、 4…タブ、5…タブ吊がリード、6…リード、7

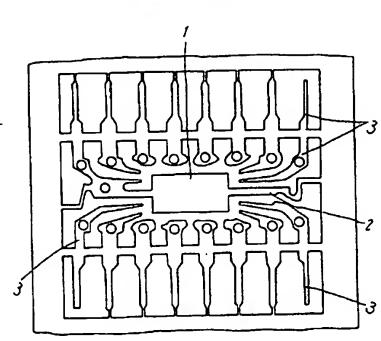
…樹庭穴。8 … 突出部、9 … 半導体チェブ、10 …コネクタワイヤ、11…樹脂對止体、12… yeadfanl

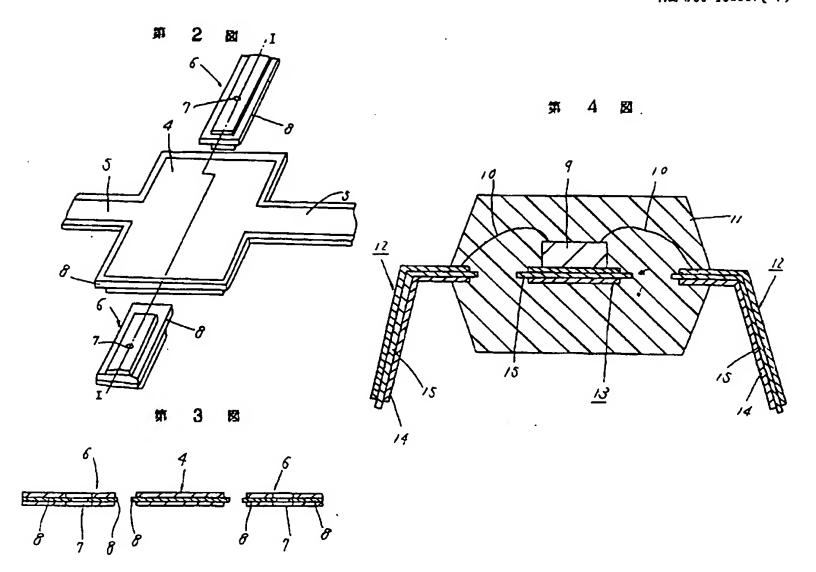
ードフレーム、18…チブ、14…リード、15

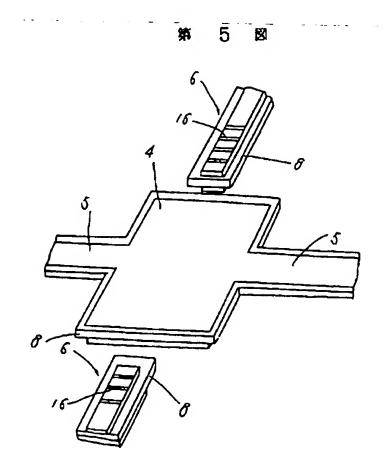
…突出部、16…牌部。

4577.191

代理人 弁聖士







Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.